

### FEATURES

- $\varnothing$  800  $\mu\text{m}$  active area
- Low slope multiplication curve
- High speed, low noise
- NIR enhanced

### DESCRIPTION

0.50 mm<sup>2</sup> High Speed, Low Noise Avalanche Photodiode with N on P construction. Hermetically packaged in a TO-52-S1 with a clear borosilicate glass window cap.

### APPLICATIONS

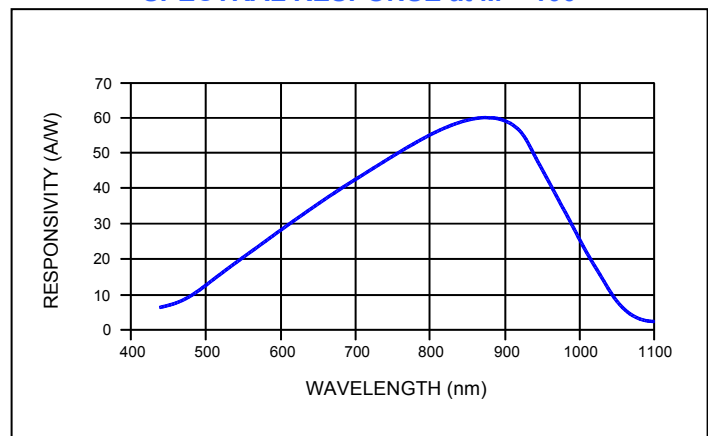
- High speed optical communications
- Laser range finder
- Medical equipment
- High speed photometry



### ABSOLUTE MAXIMUM RATING

SYMBOL	PARAMETER	MIN	MAX	UNITS
T <sub>STG</sub>	Storage Temp	-55	+125	°C
T <sub>OP</sub>	Operating Temp	-40	+100	°C
T <sub>SOLDERING</sub>	Soldering Temp 10 seconds		+260	°C
	Electrical Power Dissipation @ 22°C	-	100	mW
	Optical Peak Value, once for 1 second	-	200	mW
I <sub>PH</sub> (DC)	Continuous Optical Operation	-	250	$\mu\text{A}$
I <sub>PH</sub> (AC)	Pulsed Signal Input 50 $\mu\text{s}$ "on" / 1 ms "off"	-	1	mA

### SPECTRAL RESPONSE at M = 100



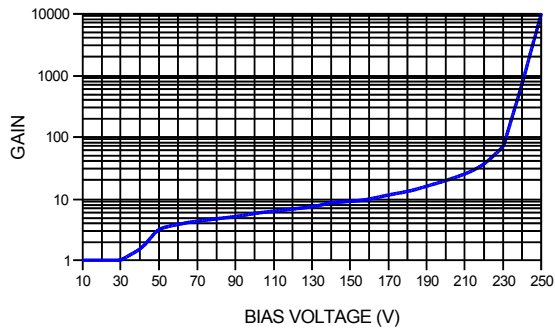
### ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS @ 22 °C

SYMBOL	CHARACTERISTIC	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I <sub>D</sub>	Dark Current	M = 100*	---	2.0	6.0	nA
C	Capacitance	M = 100*	---	2.0	---	pF
V <sub>BR</sub>	Breakdown Voltage	I <sub>D</sub> = 2 $\mu\text{A}$	180	240	---	V
	Temperature Coefficient of V <sub>BR</sub>		---	1.55	---	V/K
	Responsivity	M = 100; = 0 V; $\lambda$ = 905 nm	55	60	---	A/W
$\Delta f_{3dB}$	Bandwidth	-3dB	---	0.3	---	GHz
t <sub>r</sub>	Rise Time	M = 100	---	900	---	ps
	Optimum Gain		50	60	---	
	"Excess Noise" factor	M = 100	---	2.5	---	
	"Excess Noise" index	M = 100	---	0.2	---	
	Noise Current	M = 100	---	3.0	---	pA/Hz <sup>1/2</sup>
	Max Gain		200	---	---	
NEP	Noise Equivalent Power	M = 100; $\lambda$ = 905 nm	---	4.0 X 10 <sup>-14</sup>	---	W/Hz <sup>1/2</sup>

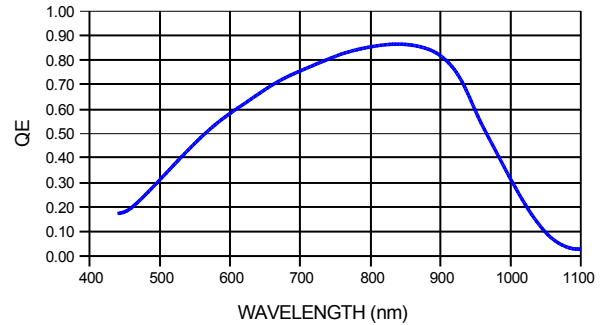
\* Measurement conditions: Setup of photo current 10 nA at M = 1 and irradiated by a 880 nm, 80 nm bandwidth LED. Increase the photo current up to 1  $\mu\text{A}$ , (M = 100) by internal multiplication due to an increasing bias voltage.

Disclaimer: Due to our policy of continued development, specifications are subject to change without notice.

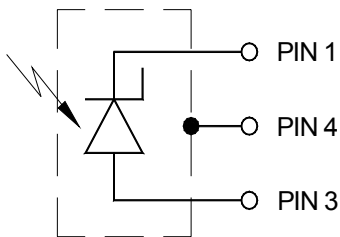
## TYPICAL GAIN vs BIAS VOLTAGE



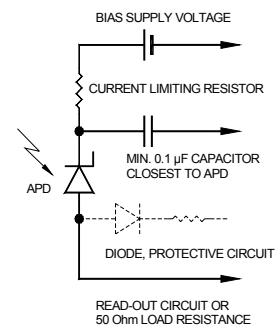
## QUANTUM EFFICIENCY for M = 100



## DEVICE SCHEMATIC



## SUGGESTED CIRCUIT SCHEMATIC



## APPLICATION NOTES

- Current should be limited by a protecting resistor or current limiting IC inside the power supply.
- Use of low noise read-out IC.
- For high gain applications ( $M > 50$ ) bias voltage should be temperature compensated.
- For low light level applications, blocking of ambient light should be used.

## HANDLING PRECAUTIONS:

- Soldering temperature - 260°C for 10 seconds max. The device must be protected against solder flux vapor.
- Minimum pin length - 2 mm
- ESD protection - Standard precautionary measures are sufficient.
- Storage - Store devices in conductive foam.
- Avoid skin contact with window.
- Clean window with Ethyl alcohol if necessary.
- Do not scratch or abrade window.

### USA:

Pacific Silicon Sensor, Inc.  
 5700 Corsa Avenue, #105  
 Westlake Village, CA 91362 USA  
 Phone (818) 706-3400  
 Fax (818) 889-7053  
 Email: [sales@pacific-sensor.com](mailto:sales@pacific-sensor.com)  
[www.pacific-sensor.com](http://www.pacific-sensor.com)

### International sales:

Silicon Sensor International AG  
 Peter-Behrens-Str. 15  
 D-12459 Berlin, Germany  
 Phone +49 (0)30-63 99 23 10  
 Fax +49 (0)30-63 99 23 33  
 Email: [sales@silicon-sensor.de](mailto:sales@silicon-sensor.de)  
[www.silicon-sensor.de](http://www.silicon-sensor.de)

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Pacific Silicon Sensor:](#)

[AD800-9-TO52-S1](#)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9